

# SM2082K

## 特点

- ◆ 本司专利的恒流控制技术
  - a) OUT 端口输出电流外置可调, 范围 5mA~60mA
  - b) 芯片间输出电流偏差 $\leq\pm 4\%$
- ◆ 输入电压: 120Vac/220Vac
- ◆ 支持可控硅调光应用电路
- ◆ 具有过温调节功能
- ◆ 芯片可与 LED 共用 PCB 板
- ◆ 线路简单、成本低廉
- ◆ 封装形式: TO252-2、SOT89-3

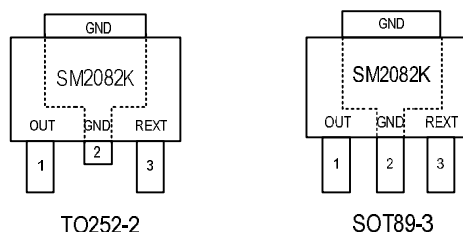
## 应用领域

- ◆ 灯丝灯
- ◆ LED 球泡灯, 筒灯
- ◆ 其它 LED 照明应用

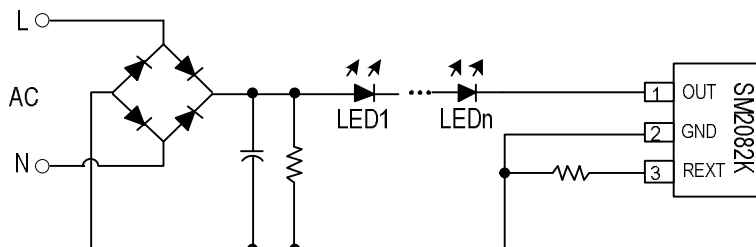
## 概述

SM2082K 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术, 输出电流由外接  $R_{ext}$  电阻设置为 5mA~60mA, 且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化, 具有较好的恒流性能。系统结构简单, 外围元件极少, 方案成本低。

## 管脚图

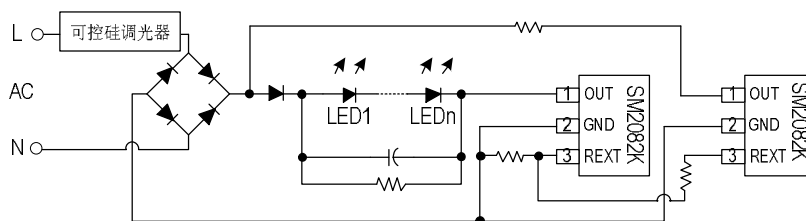


## 典型应用一 非调光方案应用电路

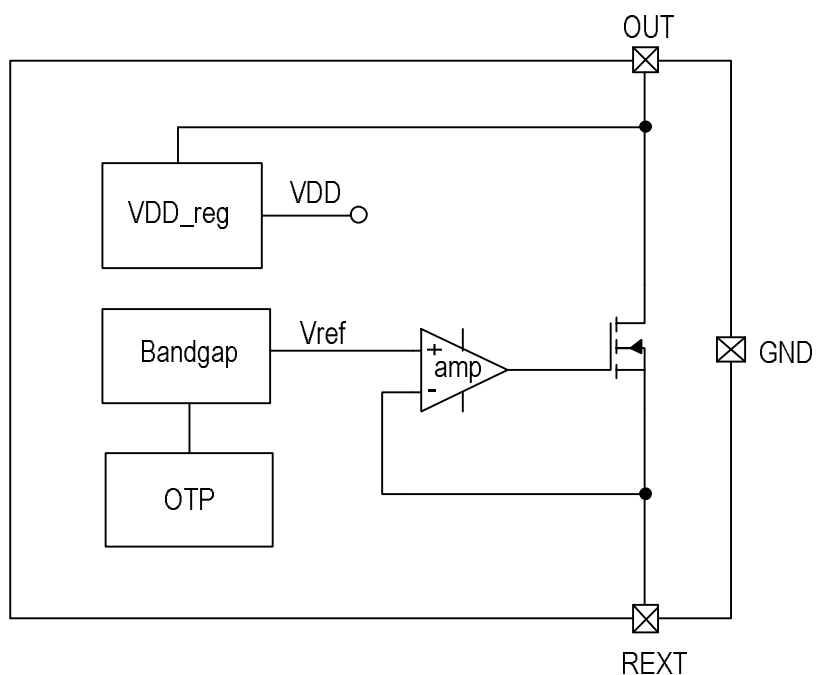


备注: 上图电源可以是交流电源, 也可为直流电源。

## 典型应用二 调光方案应用电路



## 内部功能框图



## 管脚说明

TO252-2 / SOT89-3		
管脚序号	管脚名称	管脚说明
1	OUT	电源输入与恒流输出端口
2	GND	芯片地
3	REXT	输出电流值设置端口

## 订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
SM2082K	TO252-2	40000 只/箱	2500 只/盘	13 寸
	SOT89-3	/	4000 只/盘	13 寸

## 极限参数

若无特殊说明，环境温度为 25°C。

符号	说明	范围		单位
V <sub>OUT</sub>	OUT 端口电压	-0.5~500		V
V <sub>REXT</sub>	REXT 端口电压	-0.5~8		V
R <sub>θJA</sub> <sup>注1</sup>	PN 结到环境的热阻	TO252-2	55	°C/W
		SOT89-3	125	
T <sub>J</sub>	工作结温范围	-40~150		°C
T <sub>STG</sub>	存储温度	-55~150		°C
V <sub>ESD</sub>	HBM 人体放电模式	>2		KV

注 1: 散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。实际应用条件下的热阻值会与测试值存在一定差异，使用者可选择适当的封装与 PCB 布局，以达到理想的散热表现。

## 电气工作参数

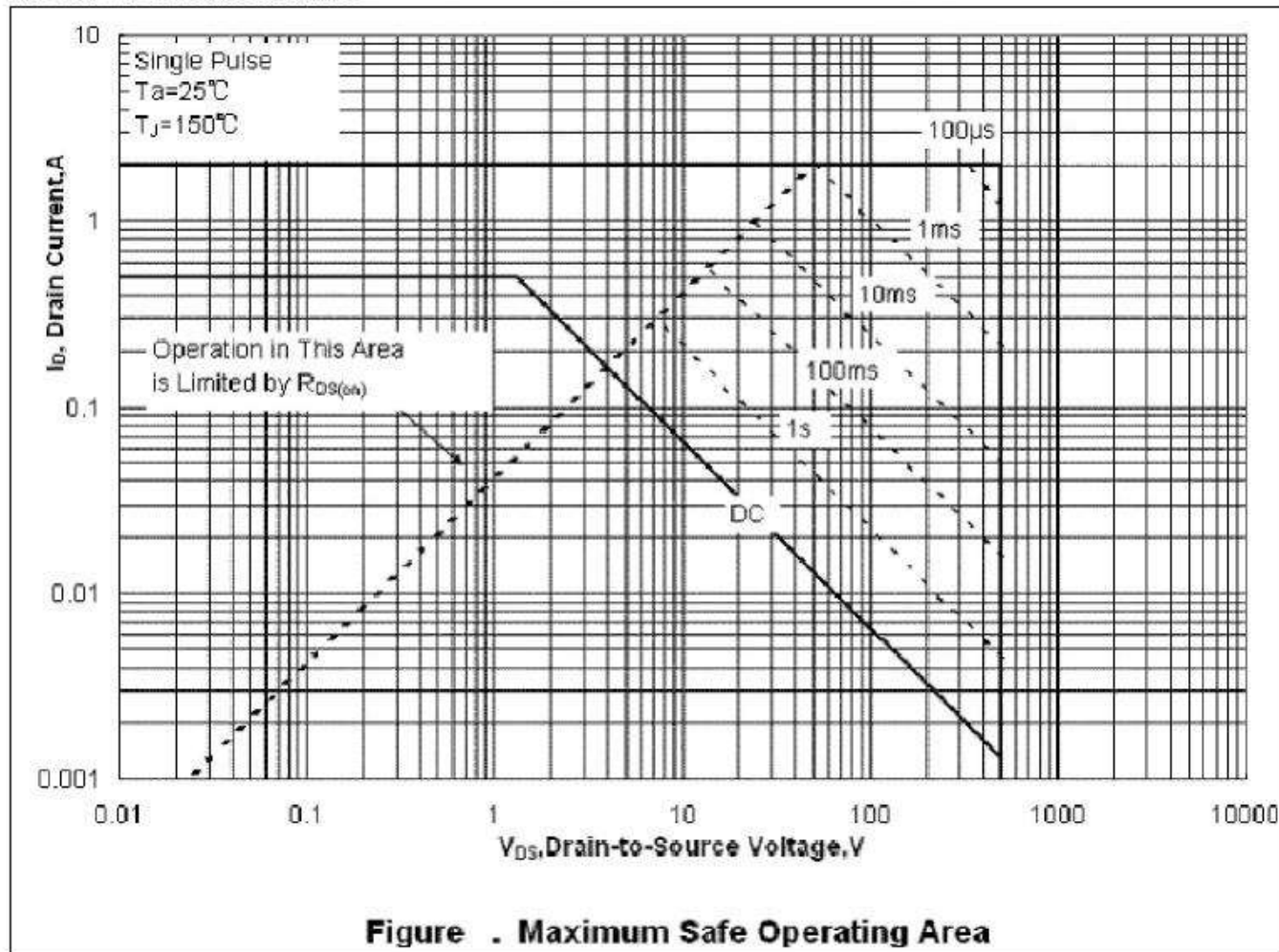
若无特殊说明，环境温度为 25°C。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OUT_MIN</sub>	恒流拐点	I <sub>OUT</sub> =30mA	-	-	6.5	V
V <sub>OUT_BV</sub>	OUT 端口耐压	-	500	-	-	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	-	5	-	60	mA
I <sub>DD</sub>	静态电流	V <sub>OUT</sub> =10V, REXT 悬空	0.1	0.16	0.25	mA
V <sub>REXT</sub>	REXT 端口电压	V <sub>OUT</sub> =10V	0.29	0.3	0.31	V
D <sub>IOUT</sub>	I <sub>OUT</sub> 片间偏差	I <sub>OUT</sub> =30mA	-	±4	-	%
T <sub>SC</sub>	电流负温度补偿起始点 <sup>注2</sup>	-	-	150	-	°C

注 2: 电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 150°C。

### SOA 曲线

#### G. 500V NLD MOS SOA



## OUT 端口输出电流特性

SM2082K 的 OUT 端口输出电流计算公式： $I_{OUT} = \frac{V_{REXT}}{R_{ext}} = \frac{0.3V}{R_{ext}(\Omega)}$  (A)。

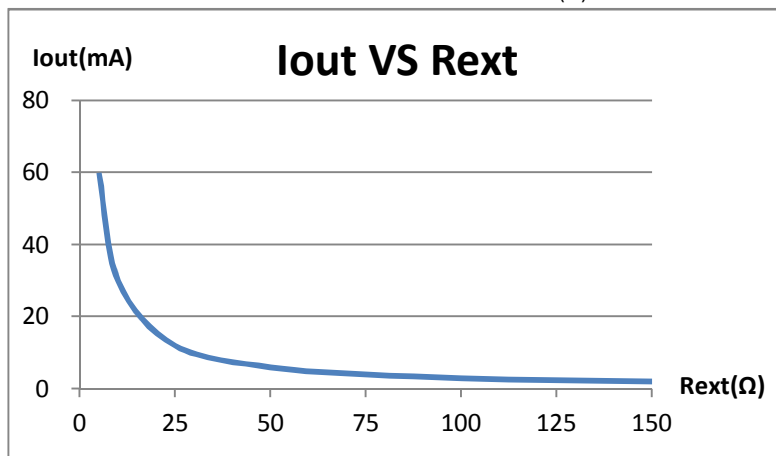


图 1. SM2082K 输出电流与 Rext 电阻关系曲线

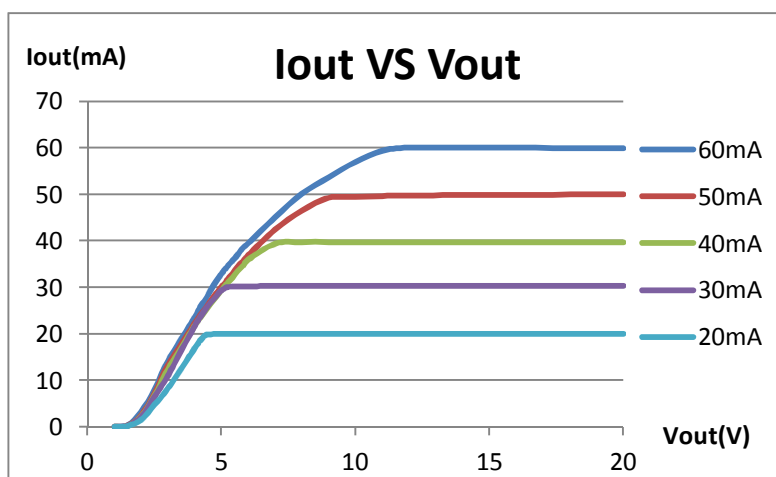


图 2. SM2082K 恒流曲线图

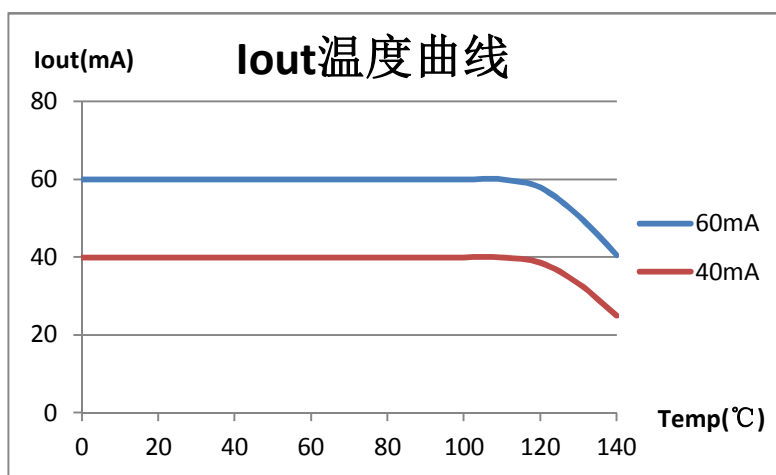


图 3. SM2082K 输出电流温度特性<sup>注3</sup>

注 3: 芯片焊接到 2mm\*2mm, 厚度为 1mm 的铝基板上。

## 过温调节功能

当 LED 灯具内部温度过高, 会引起 LED 灯出现严重的光衰, 降低 LED 使用寿命。SM2082K 集成了温度补偿功能, 当芯片内部达到 150°C 过温点时, 芯片将会自动减小输出电流, 以降低灯具内部温度。

## 系统方案设计

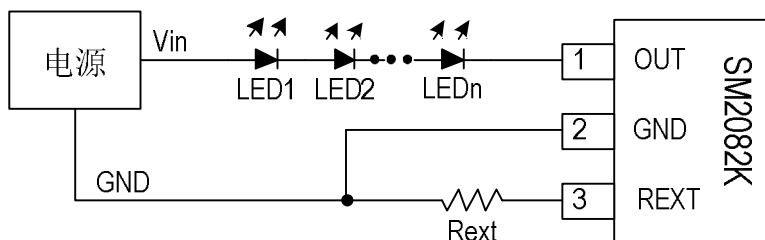


图 4. SM2082K 应用电路原理图

### ◆ 效率设计理论

图 4 所示的应用电路工作效率计算如下:

$$\eta = \frac{P_{LED}}{P_{IN}} = \frac{n * V_{LED} * I_{LED}}{V_{IN} * I_{LED}} = \frac{n * V_{LED}}{V_{IN}}$$

其中  $V_{in}$  是系统输入电源电压,  $V_{LED}$  是单个 LED 工作电压降,  $I_{LED}$  是 LED 平均电流。可看出系统串联的 LED 数量  $n$  越大, 系统工作效率越高。

系统设计过程中, 需根据应用环境调整 SM2082K 的 OUT 端口工作电压, 优化  $\eta$  值。

### ◆ LED 串联数量设计

系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面:

- 1) 图 4 电路中, OUT 端口电压  $V_{OUT} = V_{in} - n * V_{LED}$ , 为保证芯片正常工作, 需保证 OUT 端口电压  $V_{OUT} \geq V_{OUT\_MIN}$ ;
- 2) 芯片 OUT 端口电压越低, 系统工作效率越高。

综合以上两点, 系统串接的 LED 数量  $n$  计算为:

$$n = \frac{V_{in} - V_{out}}{V_{LED}}$$

## 芯片应用说明

### ◆ 单颗芯片应用说明

图 5 是 SM2082K 交流电源应用方案电路图，LED 灯可采用串联、并联或者串、并结合连接方式；C1 是电解电容，用于降低 Vin 电压纹波；Rext 电阻用于设置 LED 灯工作电流。

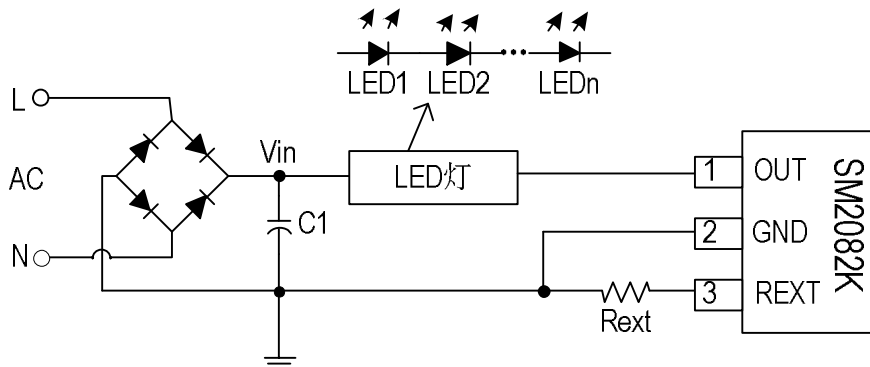


图 5. SM2082K 典型应用电路—交流电源输入

电解电容 C1 值越大，电压 Vin 纹波越小，SM2082K OUT 端口电压纹波越小。C1 值根据 LED 灯总工作电流而定：电流越大，C1 容值越大。具体计算方法如下：

$$\text{滤波电容 C1 容值: } C1 = \frac{I_{LED} * t}{\Delta V}$$

公式中， $I_{LED}$  为整个方案中的平均电流，时间 t：在 50Hz 时约为  $(1/4) * (1/f_{AC}) = 5ms$ ， $\Delta V$  是 OUT 端口电压纹波。

### ◆ 芯片并联应用说明

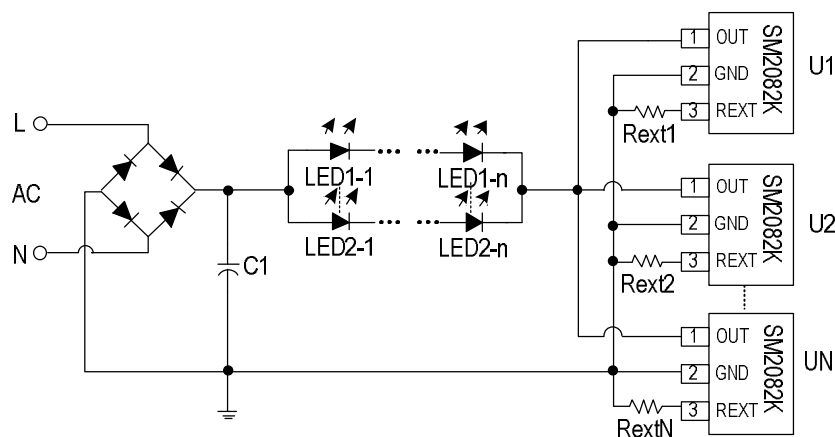


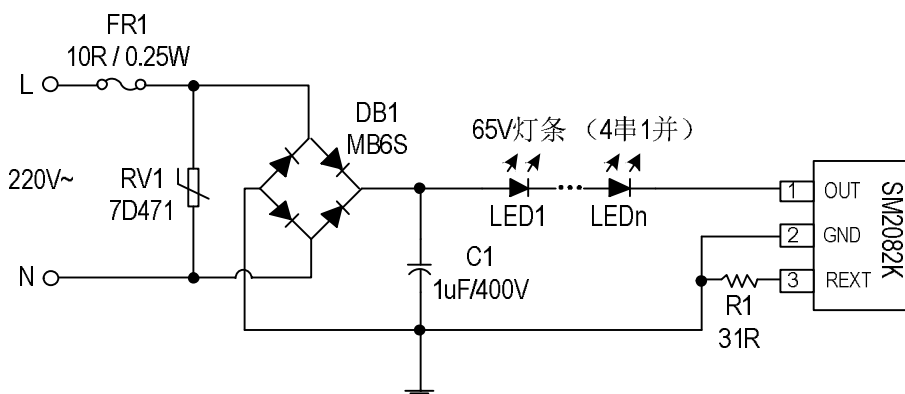
图 6. SM2082K 并联应用电路原理图

根据 LED 灯工作电流选择并联芯片数量，图中  $R_{ext1} \sim R_{ext(n+1)}$  的电阻值电阻值建议设置相同，以确保每个通道的平均电流均匀分布。

## 典型应用方案

### ◆ 方案一

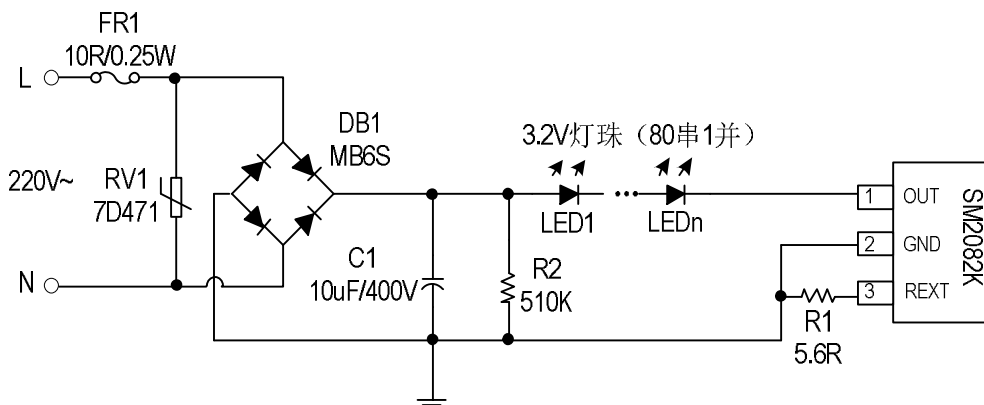
#### SM2082K SOT89-3 封装无频闪应用方案 (3W)



1. LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值。

### ◆ 方案二

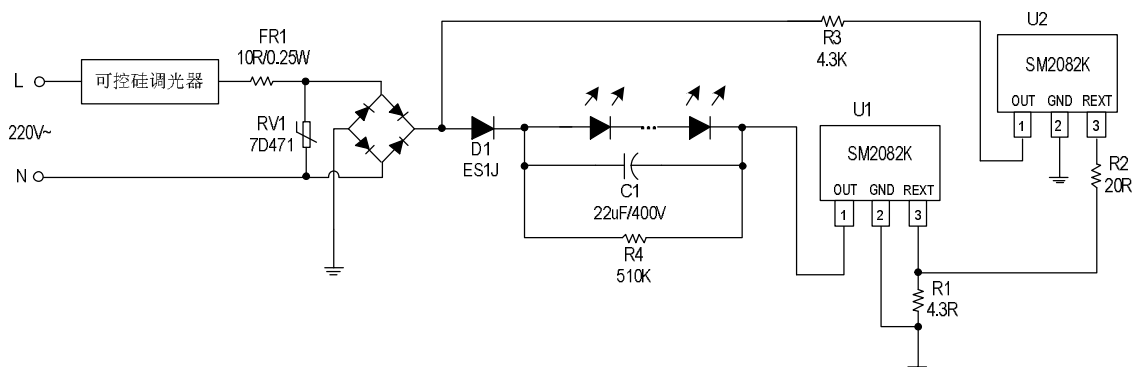
#### SM2082K TO252 封装无频闪应用方案 (16W)



1. LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值。

### ◆ 方案三

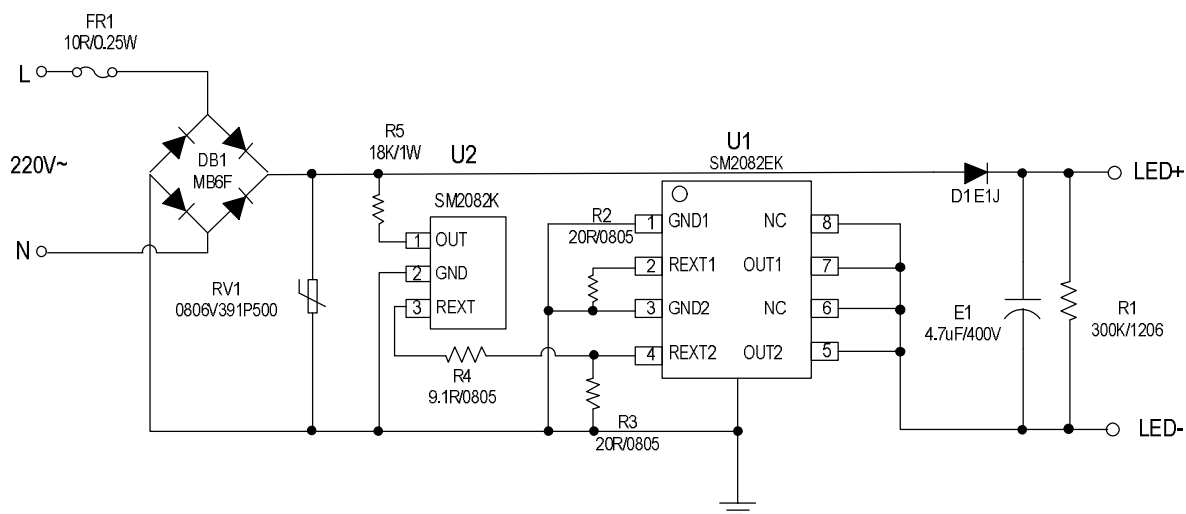
#### SM2082K TO252 封装可控硅调光应用方案 (12W)



1. LED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值，改变 R2 电阻值，调整泄放电流值。
3. R3 为 1W 的功率电阻，用于降低 U2 SM2082K 的功耗。

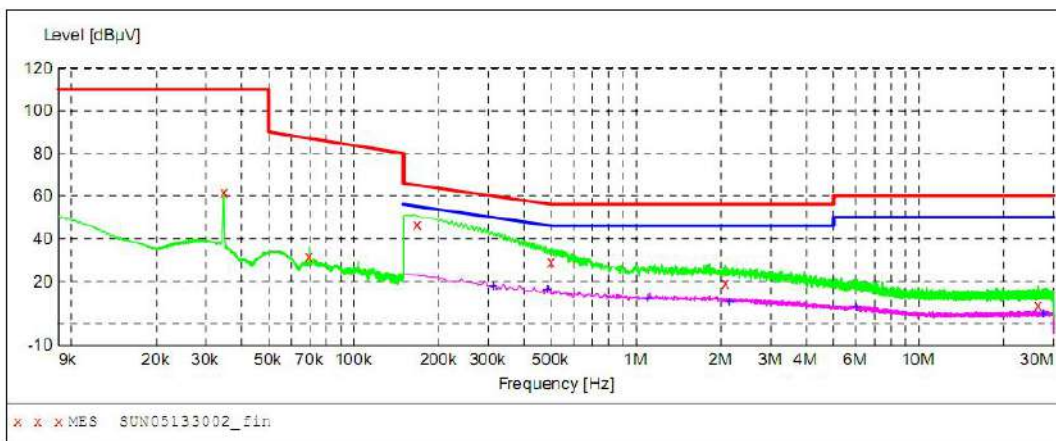


## 典型应用方案 EMI 测试



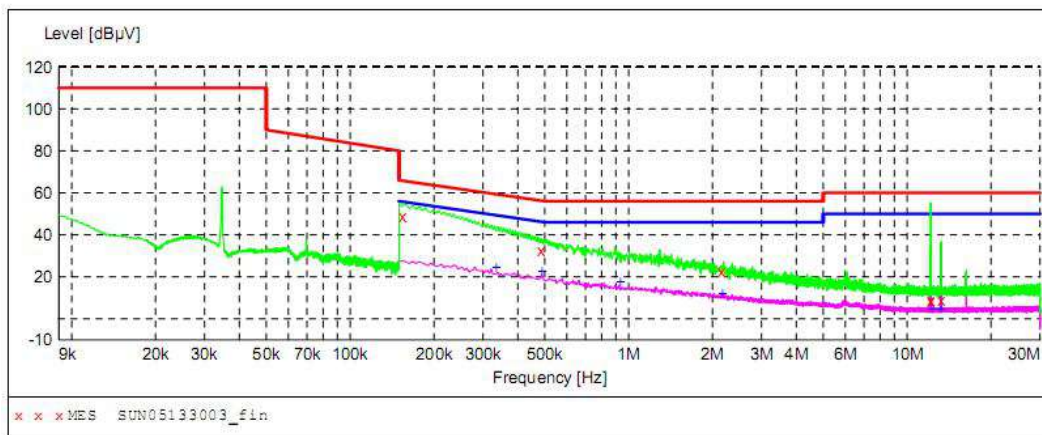
EMI 测试：N 线测试结果

SCAN TABLE: "Voltage (9K-30M) FIN"  
Short Description: 150K-30M Voltage



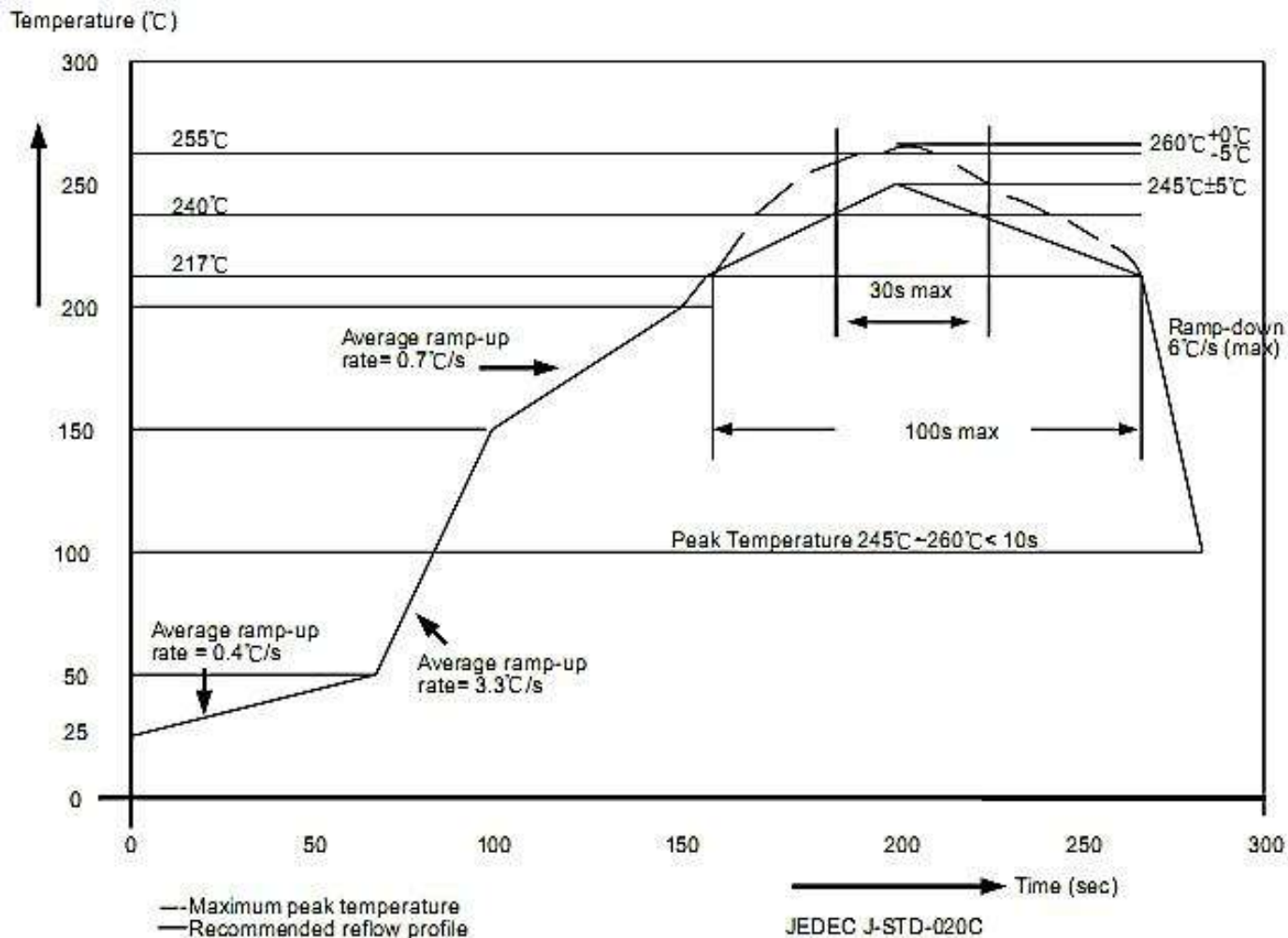
EMI 测试：L 线测试结果

SCAN TABLE: "Voltage (9K-30M) FIN"  
Short Description: 150K-30M Voltage



## 封装焊接制程

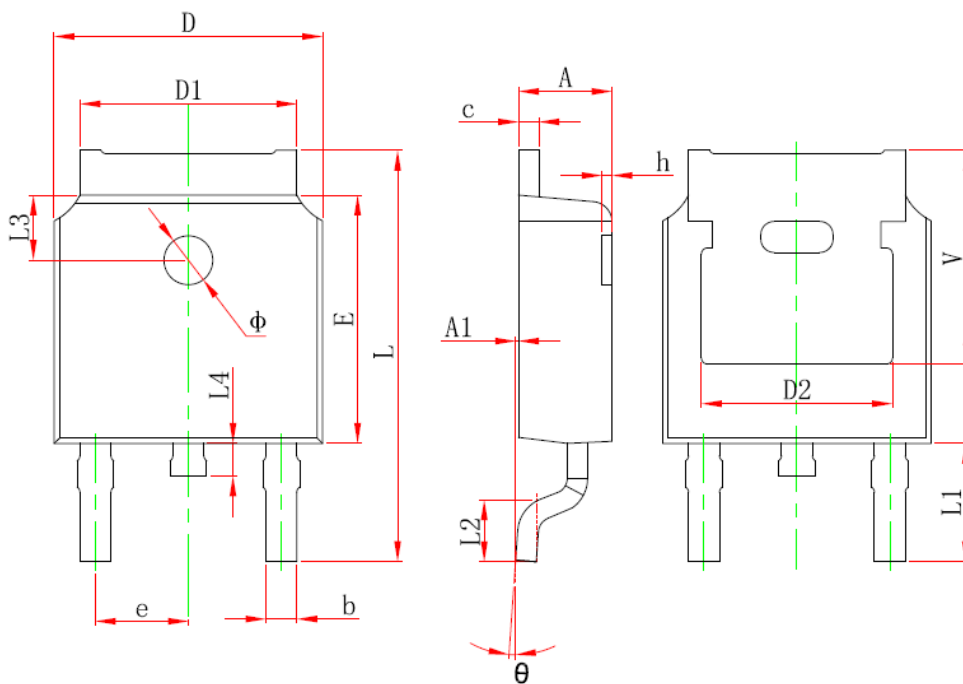
我们所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。



封装厚度	体积 mm <sup>3</sup> < 350	体积 mm <sup>3</sup> : 350-2000	体积 mm <sup>3</sup> ≥ 2000
<1.6mm	260+0°C	260+0°C	260+0°C
1.6mm~2.5mm	260+0°C	250+0°C	245+0°C
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C

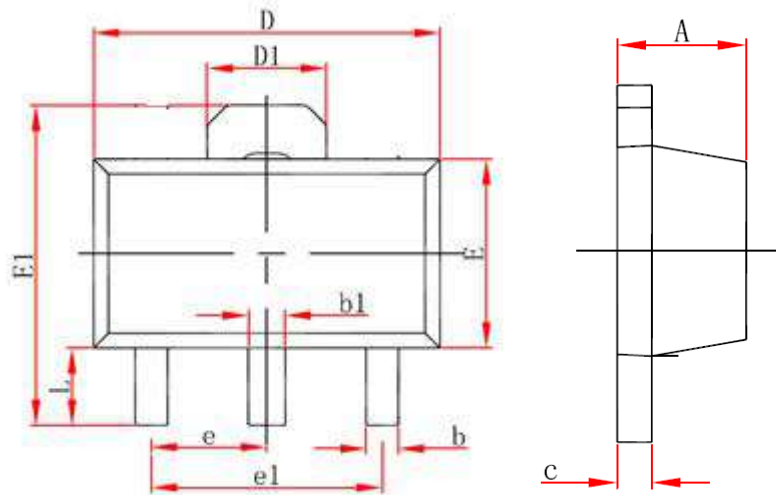
封装形式

T0252-2



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	2.0	2.7
A1	-	0.2
b	0.5	1.1
c	0.3	0.8
D	6.3	6.9
D1	4.9	5.7
D2	4.83(REF)	
E	5.9	6.4
e	2.086	2.486
L	9.5	10.7
L1	2.9(REF)	
L2	1.2	1.9
L3	1.6(REF)	
L4	0.4	1.2
φ	0.9	1.5
θ	0°	10°
h	-	0.5
V	5.35(REF)	

SOT89-3



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	1.3	1.8
b	0.2	0.7
b 1	0.25	0.75
c	0.2	0.6
D	4.3	4.8
E	2.2	2.8
E1	3.8	4.5
D1	1.55(REF)	
e	1.5(TYP)	
e 1	3.0(TYP)	
L	0.8	1.5

## 使用权声明

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息。

明微电子的产品，除非经过明微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，明微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权，任何个人和组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。